

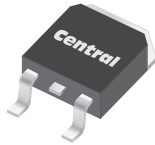
CJD31C NPN  
CJD32C PNP

**SURFACE MOUNT SILICON  
COMPLEMENTARY  
POWER TRANSISTORS**



[www.centrasemi.com](http://www.centrasemi.com)

**DPAK**  
**POWER!**



**DPAK CASE**

**DESCRIPTION:**

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CJD31C and CJD32C are complementary silicon power transistors manufactured by the epitaxial base process, mounted in a surface mount package, and designed for power amplifier and high speed switching applications.

**MARKING: FULL PART NUMBER**

**MAXIMUM RATINGS:** ( $T_C=25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted)

	SYMBOL		UNITS
Collector-Base Voltage	$V_{CBO}$	100	V
Collector-Emitter Voltage	$V_{CEO}$	100	V
Emitter-Base Voltage	$V_{EBO}$	5.0	V
Continuous Collector Current	$I_C$	3.0	A
Peak Collector Current	$I_{CM}$	5.0	A
Continuous Base Current	$I_B$	1.0	A
Power Dissipation	$P_D$	15	W
Power Dissipation ( $T_A=25^\circ\text{C}$ )	$P_D$	1.56	W
Operating and Storage Junction Temperature	$T_J, T_{stg}$	-65 to +150	$^\circ\text{C}$
Thermal Resistance	$\theta_{JC}$	8.33	$^\circ\text{C/W}$
Thermal Resistance	$\theta_{JA}$	80.1	$^\circ\text{C/W}$

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS:** ( $T_C=25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	MAX	UNITS
$I_{CEO}$	$V_{CE}=60\text{V}$		50	$\mu\text{A}$
$I_{CES}$	$V_{CE}=100\text{V}$		20	$\mu\text{A}$
$I_{EBO}$	$V_{EB}=5.0\text{V}$		1.0	mA
$BV_{CEO}$	$I_C=30\text{mA}$	100		V
$V_{CE(SAT)}$	$I_C=3.0\text{A}, I_B=375\text{mA}$		1.2	V
$V_{BE(ON)}$	$V_{CE}=4.0\text{V}, I_C=3.0\text{A}$		1.8	V
$h_{FE}$	$V_{CE}=4.0\text{V}, I_C=1.0\text{A}$	25		
$h_{FE}$	$V_{CE}=4.0\text{V}, I_C=3.0\text{A}$	10	50	
$f_T$	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=500\text{mA}, f=1.0\text{MHz}$	3.0		MHz
$h_{fe}$	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=500\text{mA}, f=1.0\text{kHz}$	20		

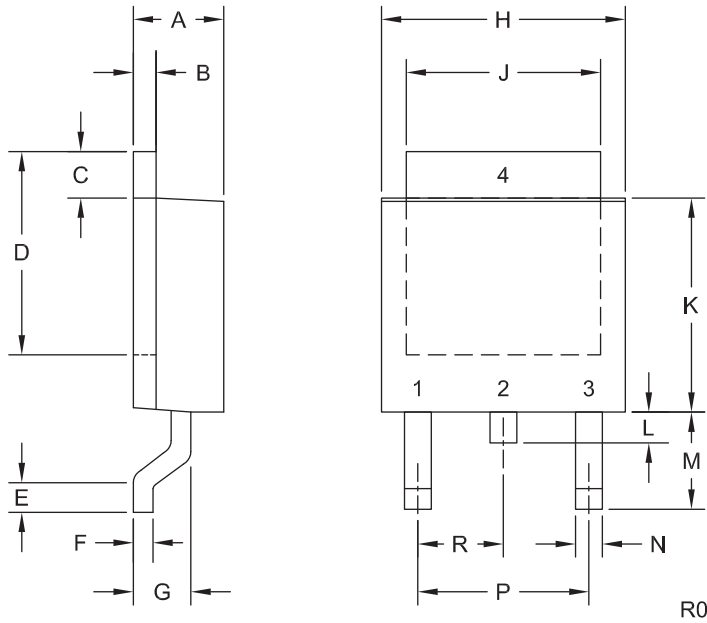
R3 (21-January 2013)

CJD31C NPN  
CJD32C PNP



**SURFACE MOUNT SILICON  
COMPLEMENTARY  
POWER TRANSISTORS**

**DPAK CASE - MECHANICAL OUTLINE**



**LEAD CODE:**

- 1) Base
- 2) Collector
- 3) Emitter
- 4) Collector

**MARKING:**

**FULL PART NUMBER**

DIMENSIONS				
SYMBOL	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.083	0.108	2.10	2.75
B	0.016	0.032	0.40	0.81
C	0.035	0.063	0.89	1.60
D	0.203	0.228	5.15	5.79
E	0.020	-	0.51	-
F	0.018	0.024	0.45	0.60
G	0.051	0.071	1.30	1.80
H	0.248	0.268	6.30	6.81
J	0.197	0.217	5.00	5.50
K	0.209	0.245	5.30	6.22
L	0.025	0.040	0.64	1.02
M	0.090	0.115	2.30	2.91
N	0.012	0.045	0.30	1.14
P	0.180		4.60	
R	0.090		2.30	

DPAK (REV: R0)

R3 (21-January 2013)



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331